特別寄稿 マイクロ・ナノ熱流体工学への誘い* (高クヌッセン数流れのミクロスケール・アナリシス)

Invitation to Micro- and Nano-Thermal Fluid Engineering (Micro-scale Analyses of High Knudsen Number Flows)

新美智秀 Tomohide NIIMI

1. はじめに

日本機械学会において「量子・分子熱流体工学」の 調査研究分科会を主宰し、平成14年4月から平成16年 3月までの2年間にわたって活動してきた.この分科 会は主に日本機械学会の流体工学部門および熱工学部 門に所属する研究者を中心に構成し、さらなる微細化 が要求される半導体製造プロセスやマイクロマシン技 術、量子・分子レベルからの解明が必要な環境問題や 宇宙工学関連の問題等のシーズを掘り起こすととも に、これら熱流体現象の実験的解明および量子・分子 モデルの開発・応用、分子シミュレーション技術等に ついて活発に議論した. 流体や熱工学に関連した各種 学会の講演会では,最近「量子・分子熱流体工学」を はじめとして,「原子・分子流れの先端技術への応用」 や「分子スケールの流れ」などのオーガナイズドセッ ションが企画されるようになり、数多くの講演が行わ れている.このように、超高真空やマイクロ・ナノデ バイスを扱う先端技術をはじめとして、原子・分子レ ベルで熱流体現象を理解する必要性が高まってきてお り、このような分野は「マイクロ・ナノ熱流体工学」 や著者らが提唱している「高クヌッセン数流れ」など と呼ばれている.

本レビューでは、このような熱流体工学の新分野で あるマイクロ・ナノ熱流体工学に関連した基礎的事項 を解説するとともに、著者らが現在推進している研究 内容および結果を簡単に紹介する.

2. 高クヌッセン数流れ

熱流体現象を原子・分子レベルで扱うことが必要か どうかは、気体流の希薄度を表わす重要な無次元パラ メータとしてクヌッセン数(Kn: Knudsen number)を 用いて判断できる. クヌッセン数は、平均自由行程 λ (Fig. 1参照)と流れ場の代表長さLを用いて $Kn = \lambda/L$ で定義され、一般にKn数が0.01を超えると、気体流は 連続体として近似できず、原子・分子の流れとして扱

* 2005年1月28日 原稿受理



Fig. 1 平均自由行程

わなくてはならない。高真空を利用する半導体薄膜製 造などの平均自由行程λが大きい場はもちろんのこと, 大気圧下でも代表長さLが数十nm程度になるMEMSや NEMS(Micro/ Nano Electro Mechanical Systems)に代 表されるナノ・マイクロデバイス近傍の流れ場もKn 数の大きな流れとなる.このような流れにおいては, 平均自由行程が大きい場合には分子間衝突数が極端に 減少して気体流中に強い非平衡現象が発現し、代表長 さが極端に小さい場合には気体分子は他の気体分子よ りも固体表面と数多く衝突するため、流れ場が固体表 面の影響を強く受けることになる. 著者らは、このよ うな流れを「高クヌッセン数流れ」と定義・総称して、 高クヌッセン数流れに関連した精緻実験データの取 得、および高クヌッセン数流れで生起するサイエンス の総合的解明の重要性を, Fig. 2を用いて多くの機会 に国内外に呼びかけている.

Fig. 3は、後述する モンテカルロ直接法 (DSMC法, Direct Simulation Monte Carlo Method) に関するバイ ブルとでも言うべきG.A.Birdの著書¹⁰に掲載されている 図を少し修正したもので、縦軸は流れ場の代表長さL, 横軸は数密度n (標準状態:n₀=2.7×10²⁵m³) であり、 Kn=0.01に対応する線が図中に破線で示してある.流 れを連続体として近似できる場合には、一般に支配方 程式としてナビエ・ストークス (NS) 方程式が利用 されるが、Kn数が0.01より大きくなると (Fig. 3の破 線の下の領域)、この近似が成立しなくなり、ボルツ マン方程式が支配方程式となる.すなわちFig. 3は、



Fig.2 高クヌッセン数流れ

-4-



Fig.3 Kn数,代表長さ,数密度の関係

前述したように,密度が低い(平均自由行程λが大きい)か代表長さLが小さいKn数の大きい流れ場では, 従来の連続体としての近似が成立せず,分子の運動を 考慮に入れて熱流体現象を原子・分子レベルで理解し なければならないことを定量的に示している.

2004年10月にハワイ島コナにおいて「Transport phenomena in micro and nanodevices (マイクロ・ナ ノデバイスにおける輸送現象)」²⁰に関する国際会議が 開催された.東京大学の笠木伸英教授が共同議長とし てこの会議を主催され,マイクロ・ナノデバイスの界 面近傍における流動,伝熱,物質輸送などに関する70 件の講演が採択された.界面近傍における熱流体現象 の解析に関しては,シミュレーションが多く,後述す るモンテカルロ直接法でシミュレーションするグルー プと境界面(壁面)にて滑り速度を与えてNS方程式 でシミュレーションするグループに大別された.これ らの発表が世界各国から十数件あったが,ほとんどの 研究者が, Fig. 3を用いて研究背景を説明し,自らの 研究が原子・分子レベルでシミュレートすべき領域に あることを示したことは興味深く,高クヌッセン数流 れが熱流体工学の今後の一つの潮流になりうることを 再認識した.

Kn数を,熱流体解析で一般に用いられる無次元数 であるレイノルズ数 (Re) と関係づけてみよう. μ :粘性係数, ρ :密度, λ :平均自由行程,a:音速, \overline{C} :分子の熱運動速さの平均値, γ :比熱比,m:分子 質量,R:気体定数,T:絶対温度とし,気体分子運動 論や圧縮性流体力学の結果として知られる以下の式,

$$\mu \cong \rho \overline{C} \lambda$$
$$\overline{C} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8}{\pi} RT}$$

 $\overline{C} \cong a = \sqrt{\gamma RT}$

が成立する場合, V:速度, L:代表長さ, M:マッ ハ数 (V/a) とすると, Re数は次式のように近似でき る³

$$Re = \frac{\rho VL}{\mu} = \frac{\rho \overline{C}\lambda}{\mu} \cdot \frac{V}{a} \cdot \frac{a}{\overline{C}} \cdot \frac{L}{\lambda} \cong \frac{V}{a} \cdot \frac{L}{\lambda} = M \cdot \frac{1}{Kn}$$

したがって,

$$Kn \cong \frac{M}{Re}$$

の関係が成立する. すなわち, 高クヌッセン数流れは, 通常の状況では(マッハ数が高くない限り), 粘性支 配の低レイノルズ数の流れと考えることもできる.

3. 分子運動と巨視的物理量

気体は非常に多くの原子や分子によって構成されて おり、これらの粒子に関する運動方程式を正しい初期 条件の下に解くことが可能であれば、通常経験する巨 視的現象も説明できると考えられる、しかし、1気圧 には1 cm³あたりに分子が2.7×10¹⁹個も存在しており、 超高真空状態やマイクロ・ナノスケールの流れを解析 する場合においても、相当数の粒子を取り扱わなけれ ばならないので、上記の方法は不可能である、したが って、統計的方法で解くしか術がなく、これにはこの 章で後述するような分子の速度分布関数が導入され る. 速度分布関数(平衡状態であればマックスウエ ル分布)の時間変化が空間、速度(外力)および分子 間衝突によって引き起こされるとした方程式が前節で 述べたボルツマン方程式である. ところが、このボル ツマン方程式は速度分布関数に関する微積分方程式 (積分項は分子間衝突に関連する)であり、分子間衝 突がほとんどなければ積分項がなくなって解析解が求 められるが、通常の条件下ではこれはほとんど不可 能である、そこで、最近はいくつかのサンプル分子を 用いて,他の分子や境界との衝突を直接計算しながら、 分子の位置と速度を刻々と変化させることで流れ場を 直接シミュレートするモンテカルロ直接法¹¹⁵が利用さ れている、この手法による計算は、ボルツマン方程式 に則していることが証明されており、低密度気体流や マイクロ・ナノスケールの流れの解析には非常に有力 である.

ここで,速度分布関数のイメージをつかんでいただ くために,数式を用いて少し考えてみよう.分子の速 度3成分が,それぞれ c_x-c_x+dc_x, c_y-c_y+dc_y, c_z-c_z+dc_zであ る割合を

 $f(c_x, c_y, c_z) dc_x dc_y dc_z$

とすると、体積dV=dxdydzの中の分子の数は、nを数

密度(単位体積中の分子数)とすると,

 $ndxdydz f(c_x, c_y, c_z) dc_xdc_ydc_z$

となる.一般に速度分布は位置と時間によっても変化 するからfは $f(c_x, c_y, c_x, x, y, z, t)$ の七つの変数であり, これを速度分布関数と呼ぶ.あらゆる速度の分子を集 めればndxdydzであるから,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f dc_x dc_y dc_z = 1$$

となり、流速(巨視的速度)のx方向成分は

$$u = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} fc_x dc_y dc_z = \overline{c_x}$$

で与えられる. 流速のx方向, z方向成分のv, wも同様 に計算できる. 巨視的に見て静止している気体(流速 がない状態)の分子でも,もちろんランダムな熱運動 はしているが,その場合のu, v, wは0,すなわち静止 気体であるので当然ではあるが平均速度は0となる. 一方,巨視的な流れのある場合の分子速度c(c, c, c) は,平均速度u, v, wに熱運動の速度C(C, C, C)を加え ることで,次式のように与えられる.

 $C_x = u + C_x$, $C_v = v + C_v$, $C_z = w + C_z$

分子の並進エネルギーは熱運動に関連したエネルギー であり,温度を熱運動のエネルギーの平均値に関係し た量として次式のように定義されている.なお, e_nは 分子1個あたりの平均運動エネルギーである.

$$e_{tr} = \frac{3}{2}kT = \overline{\frac{1}{2}mC^2} = \frac{1}{2}m\overline{(C_x^2 + C_y^2 + C_z^2)}$$

速度分布関数を用いれば,次式のようにも与えられる.

$$e_{tr} = \frac{1}{2}m(C_x^2 + C_y^2 + C_z^2)$$

= $\frac{1}{2}m\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\left[(c_x - u)^2 + (c_y - v)^2 + (c_z - w)^2\right]fdc_xdc_ydc_z$

ここでは温度Tが分子の運動エネルギーや速度分布関

-5-

数と関連付けられることを示したが、この例のように 速度、エネルギー、温度などの巨視的物理量は分子運 動によって説明できる.さらに分子運動を統計的に考 察(統計熱力学)すれば、エントロピーの本来の意味 や分子運動と完全気体の状態方程式との関係なども明 らかになるが、これらは紙面の都合で割愛する(例え ば文献4)5)参照).

さらに、熱運動速度の大きさ(速さ) C=|C|の平均 値はほぼ音速に等しく、巨視的流速の大きさc=|c|は、 通常ではc≪Cである.このような高速で運動する原 子・分子の熱運動によって、空間中の仮想的な面を通 して質量、運動量、エネルギーが輸送されると、 Table 1に示すように、巨視的にはそれぞれ拡散、粘 性、熱伝導の現象が現れる.たとえば、空間中のある 面の上と下に速度差があり、上の速度が大きいとする と、速度の遅い下の分子が上に移動した場合には、運 動量の小さい分子が上に侵入したことになり、上の領 域の速度を遅くしようと作用する.これを巨視的に考 えれば、粘性が現れたことになる.

 Table 1
 分子により輸送される物理量と巨視的熱流体

 現象

分子により 輸送される物理量	巨視的熱流体現象
質量	拡散
運動量	粘性
エネルギー	熱伝導

この章では、一般の巨視的熱流体現象は分子運動、 分子間衝突と関連付けられることを述べてきたが、本 レビューの主題である高クヌッセン数流れの場合に は、流れ場は分子間衝突よりも分子と固体表面との衝 突によって形成され、分子が固体表面とどのように相 互作用するかの方が重要になる。

4. 高クヌッセン数流れの総合的理解に向けて

いわゆるナノテクノロジーにおいては、デバイスの 構築・形成に重点が置かれているが、これらは作動時 においては常に雰囲気ガスと接触しているために、気 体分子とデバイスとの相互作用が非常に重要であるに もかかわらず、そこには力点が置かれていない、今後 のMEMS/NEMSなどのナノ・マイクロデバイスの開 発には,第2章でも述べたように,これらを取り巻く 高クヌッセン数流れの理解,すなわち流れ場の原子・ 分子オーダでの理解と固体表面近傍における原子・分 子の挙動の理解が必要である.たとえば固体表面にお ける気体分子の運動量やエネルギー交換,吸着確率, 速度すべり,温度飛躍などのデータは,デバイス開発 には特に重要である.

4.1 気体分子と固体表面との相互作用

固体表面に入射した気体分子が完全に表面温度Tの 平衡状態になった後に表面から散乱された場合,その 散乱された分子群の速度分布は,温度Tの平衡状態に ある気体が孔から流出する分子群のそれと同様に与え られ,流束強度(単位面積,単位時間に散乱される分 子数)はFig.4(a)のように円形となり(Cosine法則), 拡散反射(Diffuse reflection)と呼ばれる.しかし, 表面が清浄になると,流束強度分布がFig.4(b)のよう に葉状の散乱分布(Lobular scattering)へと変化する. 清浄表面では,固体表面に吸着されずに平衡状態に達 する前に散乱される気体分子が増加するためである. この分布は,気体分子と固体表面の干渉特性を反映し た結果を与えるため,拡散反射と比較して多くの有用 な情報を含んでいる(詳細は参考文献5)の4章参照).



Fig. 4 分子の流束強度分布

気体分子が固体表面と干渉すると,エネルギーと運動量が交換される.エネルギー交換と運動量交換の素 過程の表現として適応係数(Accommodation coefficient) が定義され,⁹ たとえばエネルギー適応係数は次式で与 えられる.

$$\alpha = \frac{\overline{E_i} - \overline{E_r}}{\overline{E_i} - \overline{E_s}}$$

ここで, *E*_iは入射分子の平均並進運動エネルギー, *E*_rは反射分子の平均並進運動エネルギー, *E*_sは反射 分子速度分布が固体表面の温度に相当するマックスウ ェル分布であるときの平均並進運動エネルギーである。運動量適応係数も表面に対する接線方向および法 線方向の運動量について同様に定義される。拡散反射 の場合には、気体分子が完全に固体表面と平衡して散 乱 $(\overline{E_r} = \overline{E_s})$ されるので、 $\alpha = 1$ (完全適応)となる。

4.2 面・分子干渉実験

上記のような散乱分子の流束強度分布や適応係数に 関するデータを実験的に得るにはどうすればよいか. これには一般に,分子線(Molecular beam)を用いた 面・分子干渉実験装置が用いられる(Fig. 5参照).真 空中に噴出する超音速自由噴流の中心軸上の分子をス キマーにより抽出すると,速度のそろった一群の分 子,すなわち分子線を得ることができる.これを固体 表面に衝突させ,反射前後の分子の速度分布を飛行時 間法により求めると,気体分子が固体表面とどのよう な相互作用(面・分子干渉),たとえばエネルギー交 換,運動量交換を行ったかを知ることができる.



Fig.5 面·分子線干涉実験装置概略

これまで反射分子の検出器には,主に質量分析器が 利用されていた.しかし,これは基本的に密度(流束 強度)を検出するのみで,分子の内部状態を計測する ことはできない.したがって,分子の固体表面との干 渉による内部エネルギーを含めたエネルギー交換に関 する情報を高感度で計測するには分光学的な計測手法 が必要となる.

気体流における分子のレーザ光との相互作用を利用 した代表的なセンシング技術をTable 2にまとめた^{η} これらは、分子それ自体からの発光や散乱を利用して おり、流れ場の局所的な物理量のセンシングが可能で ある. Table 2のLIF (レーザ誘起蛍光法), CARS (コ ヒーレント・アンチストークス・ラマン散乱), DFWM(縮退4光波混合), Rayleigh散乱, Raman散 乱の原理については他書の解説にゆずるが5-11,この 中で最も感度の高いLIFでも10¹² molecules/cm³程度で あり、分子線実験に適応できるほどの感度は有してい ない。一方REMPIは、基底準位に存在する気体分子 を多光子により共鳴準位を介してイオン化準位へと遷 移させ、イオン電流の検出から基底準位のエネルギー 分布を計測する手法であり、非常に高感度である.1213 たとえば、窒素の2R+2 REMPI¹⁴では10⁹ molecules /cm³, 2R+1 REMPI¹⁵では10⁵ molecules/cm³の検出感 度が報告されている.^{16) 17)}

そこで私の研究室では、この面・分子干渉実験装置 にREMPIシステムを組み込み、REMPIによる反射分 子の内部エネルギーの計測および飛行時間法を実現す るためのFig. 6に示す実験装置を構築中である.これ らにより気体分子の固体表面との内部エネルギーを含 めたエネルギー交換、運動量交換、反射分子の流束強 度分布の反射角度依存性、吸着確率と吸着脱離現象、 適応係数、反射分子の内部エネルギーの非平衡性など を調査し、これらをデータベース化する計画である.

4.3 高ヌッセン数流れにおける固体表面上の圧力 計測

一般に固体表面上の圧力計測には圧力タップが利用 される.しかし,低密度気体流の場合にはタップに結 合した細管のコンダクタンスや高精度な圧力計の結合 が必要などの問題があり,これの低密度気体流への適 用は現実的ではない.また圧力タップのマイクロ・ナ ノデバイスへの適用も考えにくい.そこで,著者らは

Table 2 分子のレーザ光との相互作用を利用した気体流のセンシング技術

		検出信号	次元	光との相互作用	特徴
	LIF	蛍光	0~2	吸収	比較的容易,衝突失活の影響
	CARS	散乱光(コヒーレント)	0 ~ 1	散乱	理論スペクトルとの比較により計測,スペクトルか 圧力にも依存,光波の位相整合が必要
	DFWM	レーザ光	0~2	吸収,誘導放射	信号光は位相共役光,LIFとCARSの特徴を有する
	Rayleigh	散乱光	0~2	散乱	比較的強度が強い, Mie散乱との分離が困難
	Raman	散乱光	0~1	散乱	強度が弱い
	REMPI	イオン	0	吸収,イオン化	高感度計測,高真空場での検出に限られる



Fig. 6 分子線実験装置

PSP¹⁸⁾⁻²¹⁾に着目した. Fig. 7のPSPの原理に示すよう に、PSPでは一般に固体表面に発光色素をポリマーで 固定し,紫外光もしくは短波長可視光の照射による発 光が気体中の酸素分子によって消光される現象に基づ いて固体表面上の圧力が計測される。PSPでは、圧力 に対する発光強度変化をあらかじめ求め、その較正曲 線から圧力が計測されるが,ほぼ1Torr (133 Pa)以上 の圧力域で較正曲線が得られており、それ以下の低圧 力域でのデータは皆無であった。一般にPSPの発光強 度は,酸素分圧にほぼ逆比例するので,低圧力域では PSPが明るく発光するが、その発光強度変化が小さく 表面圧力の計測には適さないと考えられていた. これ が、低圧域へのPSPの適用を阻害していた要因である と思われる.しかし、1Torr以下の低圧力域ではPSP による圧力計測で問題となる圧力感度のゆらぎや経時 変化などが顕著に現れ、このような発光分子と酸素分 子との分子レベルでの相互作用が非常に重要となる低 圧力域での基礎特性の調査が、広い圧力範囲でのPSP による表面圧力計測の高精度化にも重要であると考え



Fig.7 PSPの原理

られる.

私の研究室では,初めに代表的な3種類のPSP [PtOEP/GP197,Bath-Ru/AA,PtTFPP/poly(TMSP)] を選び,これらの低圧力域(1Torr以下)における圧 力感度,発光強度の温度依存性と経時変化,圧力変化 に対する発光強度の応答などの基礎特性を調査した¹⁹⁰ **Fig. 8**にこれら3種類のPSPに関する低圧域における Stern-Volmer Plotを示す.縦軸はルミネセンス強度の 比(*I_{ref}/I*),横軸は絶対圧力(Pa)である.PtTFPP/ poly(TMSP)は,低圧力域において調査した三つの PSPの中でも最も高い圧力感度を有しており,Stern-Volmer Plotの直線性も非常に良いことが分かる.さ らにPtTFPP/poly(TMSP)は絶対的な発光強度も非常 に強く,S/Nの高い圧力計測が可能であった.



Fig. 8 Stern-Volmer Plots (発光強度の圧力依存性)

PSPの適用例として,真空中へ噴出する超音速自由 噴流が固体表面へ衝突した際の固体表面上の圧力計測 を行った.この計測には、PtTFPP/poly(TMSP)を用 いた.Fig.9は、固体表面のPSPの発光強度分布およ び計測した圧力分布の擬似カラー表示である.実験条



Fig.9 超音速自由噴流が固体表面へ衝突した際の固体 表面上の圧力

件は貯気室圧力53.9kPa,膨張室圧力133.8Pa(圧力比 403),衝突角60°,ノズルから壁面までの距離2mm, ノズル直径0.3mmである.**Fig.9**より,低圧下におい ても固体表面の圧力分布が詳細に計測できることが明 らかとなった.

現在,マイクロ・ナノデバイスへのPSPの適用を目 指して,ポリマーを用いることなく発光色素の分子膜 を固体表面へ付着させるための技術開発,および分子 膜でPSPを構成した際の発光強度の本質,すなわちど のような物理量に発光強度が依存するのかの調査を実 施している.

5. おわりに

コンピュータの発達により、世界的に見ても研究・ 開発はシミュレーション中心となり、実験的な研究・ 開発は減少の一途である. 高クヌッセン数流れの分野 でも、ご紹介したようなモンテカルロ直接法や分子動 力学法などの手法によって高精度なシミュレーション が可能となり、これとともに実験データにもさらなる 精度向上が求められるようになってきた. 私の研究室 では,防塵服を着た学生がクリーンブースの中で分子 膜製造装置、蛍光顕微鏡、AFMなどを操作して、感 圧色素膜の作成・特性評価を行い,また他の学生はタ ーボ分子ポンプやクライオポンプで排気された超高真 空装置にレーザを入射してイオンを検出するなどと, いわゆる機械系の熱流体研究室らしくない実験を遂行 しているが, これも一つには実験精度の向上を目指し ているためもある. PSPの開発は, 文部科学省の大型 プロジェクトとして「分子の眼で流れを見る,感じる、 知る」を合言葉に、熱流体や化学研究者の異分野交流 および産学連携により実施され、単独の研究者では達 成できない新しい「分子センサ」の開発を可能にした. このような新しい実験手法の開発が、実験精度の向上 につながり、ひいては新しい知見につながるものと信 じている.

本レビューでは,熱流体工学を連続体としてではな く,原子・分子レベルから考える立場もあることをご 理解いただき,さらにこの分野に興味をもっていただ ければと願って,「マイクロ・ナノ熱流体工学への誘 い」と題して執筆させていただいた.冗長および教科 書的な内容になってしまった感もあるが,お読みいた だいた方の研究・開発のご参考になれば幸いである.

<参考文献>

- G.A.Bird, Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows, Clarendon Press, Oxford (1994)
- M.Gad-el-Hak ed., Transport Phenomena in Micro and Nanodevices, Engg. Conf. Int. (ECI) (2004)
- A.H.Shapiro, The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow, John Wiley & Sons (1953)
- 4) W.G.Vincenti and C.H. Kruger, Introduction to Physical Gas Dynamics, John Wiley and Sons Inc. (1967)
- 5) 藤本哲夫,新美智秀ほか:原子・分子の流れ,共 立出版 (1996)
- 6) 新美智秀, センシング工学, コロナ社 (1992)
- 7)新美智秀,高クヌッセン数流れのレーザ・画像応 用センシング,日本機械学会熱工学コンファレン ス (2003), pp.241-244.
- 8) 新美智秀,光学的可視化手法の基礎と最前線「量 子光学の利用」,可視化情報学会講習会:可視化フ ロンティア第1回「流れの可視化計測法」(2004), pp.21-32.
- 9) 新美智秀ほか,可視化情報ライブラリー3:光学 的視化「5章 燐光,蛍光,発色,吸収の利用」,朝 倉書店(2001)
- 新美智秀ほか,可視化情報ライブラリー4:PIV と画像解析技術「3章3.4 レーザ誘起蛍光法」,朝 倉書店(2004)
- 11) A.C.Eckbreth, Laser Diagnostics for Combustion Temperature and Species, Abacus Press (1988)
- 12) T. Niimi, C. Dankert and B.K. Nazari, Resonantly Enhanced Multiphoton Ionization for Analyses of Rarefied Gas Flows, DLR-IB 223-96 A42 (1996)
- 13) 森英男,石田敏彦,青木義典,新美智秀, REMPI による超希薄気体流計測に関する研究(超音速自 由分子流におけるREMPIスペクトルの解析),機 論, B, 66, 645 (2000-5), pp.1373-1379.
- 14) K.C. Carleton, K.H. Welge and S.R. Leone, Detection of Nitrogen Rotational Distributions by Resonant 2+2 Multiphoton Ionization through the a¹Πg State, Chem. Phys.Letts., 115-6 (1985), pp.492-495.

- 15) K.R.Lykke and B.D. Kay, Two-Photon Spectroscopy of N2: Multiphoton Ionization, Laser-induced Fluorescence, and Direct Absorption via the a" ¹Σ_g⁺ state. J. Chem. Phys., 95 (4) (1991), pp.2252-2258.
- 16) 森英男,新美智秀,丹羽健二,秋山勇雄,REMPI による超音速自由分子流における回転温度非平衡 現象の解析に関する研究,機論,B,69,679 (2003-3), pp.623-629.
- 17) 新美智秀, 共鳴多光子イオン化法による超希薄気 体流計測(高クヌッセン数流れのミクロスケー ル・アナリシスを目指して), ながれ, 22-4 (2003), pp.317-323. 日本流体力学会HPよりダウンロード可能

[http://www.nagare.or.jp/nagare/22-4/22-4-t05.pdf]

新美 智秀

- 18) 新美智秀:可視化画像による物理量の複合計測, 可視化情報, Vol. 20, No.77 (2000), pp. 126-132.
- 新美智秀ほか, PSPの低圧力域における基礎特性 に関する研究, 機論, B, 68, 676 (2002), pp.3360-3368.
- 20) H. Mori, T. Niimi, M. Yoshida, M. Kondo, Y. Oshima, Application of PSP to Low Density Gas Flows, J. of Visualization, 7-1 (2004), pp.55-62.
- 21) T. Niimi, M. Yoshida, M. Kondo, Y. Oshima, H. Mori Y. Egami, K. Asai, H. Nishide, Application of Pressure-Sensitive Paints to Low Pressure Range, J. of Thermophysics and Heat Transfer, AIAA, 19-1 (2005), pp.9-16.

<著 者>



(にいみ ともひで)
 名古屋大学大学院工学研究科
 マイクロ・ナノシステム工学
 専攻 教授
 (名古屋大学 高等研究院
 併任)

1977年名古屋大学工学部機械学科卒業,1979年名古 屋大学大学院工学研究科修士課程 修了,1979年トヨ タ自動車(株)入社,1983年名古屋大学工学部助手, 1989年工学博士,同年名古屋大学工学部講師,1990年 同助教授(1996年ドイツ航空宇宙研究所),2002年同 教授.2003年10月より名古屋大学高等研究院(http:// www.iar.nagoya-u.ac.jp/)教授を併任.高クヌッセン 数流れのミクロスケール・アナリシス,レーザ応用セ ンシング技術などの研究に従事.

流れの可視化学会技術賞(1989),日本機械学会奨

励賞(1990),可視化情報学会映像展賞(1991),日本 機械学会賞論文賞(1992),可視化情報学会グッドプ レゼンテーション賞(1993),永井科学技術財団賞学 術賞(1994),日本機械学会論文賞(2001),日本機械 学会流体工学部門フロンティア表彰(2004)などを受 賞.

2002-2004年「量子・分子熱流体工学に関する調査 研究分科会」主査,2004年より日本機械学会フェロー, 2004年度日本機械学会流体工学部門技術委員長,2005 年度同副部門長などを歴任.